









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB011N04NGATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB011N04NGATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1300 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB011N04NGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1300 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	250nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB011N04NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB011N04NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB011N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB011N04NGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB011N04NG</b> INFINEON IPB011N04NG INFINEON</p>	 <p><b>IPB011N04LGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7</p>	 <p><b>IPB011N04LG</b> INFINEON IPB011N04LG INFINEON</p>	 <p><b>IPB015N04L G</b> Infineon Technologies IPB015N04L G Infineon Technologies</p>
 <p><b>IPB015N04LGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB011N04N</b> Infineon IPB011N04N Infineon</p>	 <p><b>IPB014N06NATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 34A TO263-7</p>	 <p><b>IPB014N06N</b> INFINEON IPB014N06N INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB011N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB011N04NGATMA1 Datenblatt	IPB011N04NGATMA1-Datenblätter	IPB011N04NGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB011N04NGATMA1
IPB011N04NGATMA1 Electronic	IPB011N04NGATMA1-Komponenten	IPB011N04NGATMA1-Verteiler	IPB011N04NGATMA1-Bild	IPB011N04NGATMA1-Teil
IPB011N04NGATMA1 Preis	IPB011N04NGATMA1 Hersteller	IPB011N04NGATMA1 Bild	IPB011N04NGATMA1 Aktie	IPB011N04NGATMA1 Inventar
IPB011N04NGATMA1 Neu	IPB011N04NGATMA1 Original	IPB011N04NGATMA1 garantiert	IPB011N04NGATMA1 RFQ	IPB011N04NGATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited